## **DIE-ATTACHING PASTE**

Publication number: JP10130465 Publication date: 1998-05-19

Inventor:

TAKEDA TOSHIRO; MATSUDA YUTAKA; MURAYAMA

RYUICHI; OKUBO HIKARI

Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO

Classification:

- international:

C08K3/00; C08G59/20; C08G59/30; C08G59/62; C08K5/315; C08L63/00; C08L75/04; C08L79/04; H01L21/52; C08K3/00; C08G59/00; C08K5/00;

**C08L63/00; C08L75/00; C08L79/00; H01L21/02;** (IPC1-7): C08L63/00; C08G59/30; C08G59/62; C08K3/00;

C08K5/315; C08L75/04

- European:

Application number: JP19960289450 19961031 Priority number(s): JP19960289450 19961031

Report a data error here

#### Abstract of **JP10130465**

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a die-attaching paste reduced in stress and water absorbency, excellent in adherence, and having good wire bonding properties by blending an epoxy resin, a curing agent, a cyanic acid ester or its prepolymer, and an inorganic filler with a product of the reaction of a bisphenol compound with a diglycidyl ether compound containing disiloxane in the skeleton. SOLUTION: This paste is obtained by blending essential components comprising 100 pts.wt. epoxy resin, 5-200 pts.wt. product of the reaction of an epoxy resin represented by formula I (wherein R1 and R2 are each a 1-5C divalent aliphatic group, or an organic group containing a 6C or higher aromatic ring) with a bisphenol compound having at least two phenolic hydroxyl groups in the molecule at an equivalent ratio of (0.2 to 5.0):1, a curing agent, 5-125 pts.wt. cyanic acid ester represented by formula II (wherein R3 is a divalent organic group containing an aromatic ring) and/or prepolymer thereof, and an inorganic filler having a particle diameter of at most 50&mu m.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公開番号

# 特開平10-130465

(43)公開日 平成10年(1998) 5月19日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号		FΙ							
C08L	63/00			C O	8 L	63/00			Λ		
C08G	59/30			C O	8 G	59/30					
	59/62					59/62					
C08K	3/00			C 0	8 K	3/00					
	5/315					5/315					
			審查請求	朱黼求	大幅	<b>浸</b> の数 2	OL	全	5 頁	)最終更	に続く
(21)出顧番号	<del></del>	<b>特顯平8</b> -289450		(71)	出題。	ሊ 00000	2141				
						住友/	ベークラ	イトを	大大夫	řt	
(22) 出顧日		平成8年(1996)10月31日				東京	弘川区	東品川	i 2 Г	目5番8号	
				(72)	発明	旨 竹田	敏郎				
						東京都	品川区	東品川	2 J	目5番8号	住友
						ベーク	フライト	株式会	社内		
				(72)	発明	者 松田	#				
						東京都	品川区	東品川	2	目5番8号	住友
						ペーク	フライト	株式会	社内		
				(72)	発明	皆 村山	竜一				
						東京都	阳川区	東品川	12 J	目5番8号	住友
						ベーク	<b>ライト</b>	株式名	社内		
										最終頁	に続く

## (54) 【発明の名称】 ダイアタッチペースト

## (57)【要約】

【課題】低応力性、接着性、低吸水性及びワイヤーボンディング性の良好なダイアタッチペーストを提供する。【解決手段】 (A)式(1)で示されるエポキシ樹脂(a)と分子中に2個のフェノール性水酸基を有するビスフェノール類(b)とを当量比で0.2~5.0の範囲で反応させてなる反応生成物、(B)エポキシ樹脂、(C)硬化剤、(D)式(2)で示されるシアン酸エステル及び/またはそのプレポリマー、及び(E)無機フィラーを必須成分とするダイアタッチペースト。【化1】

(式中 $R_1$  ,  $R_2$  は炭素数 $1\sim5$ の2価の脂肪族基、又は炭素数6以上の芳香族環を含む有機基を示し、互いに同じであっても異なっていてもよい)

【化2】

 $NCO-R_{\bullet}-OCN$  (2)

(式中R<sub>3</sub> は芳香族環を含む2価の有機基である)

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)式(1)で示されるエポキシ樹脂 (a)と分子中に2個のフェノール性水酸基を有するビスフェノール類(b)とを当量比で0.2~5.0の範囲で反応させてなる反応生成物、(B)エポキシ樹脂、

【化1】

(式中 $R_1$  , $R_2$  は炭素数 $1\sim5$ の2価の脂肪族基、又は炭素数6以上の芳香族環を含む有機基を示し、互いに同じであっても異なっていてもよい)

## 【化2】

$$NCO-R_{3}-OCN$$
 (2)

(式中R<sub>3</sub> は芳香族環を含む 2価の有機基である)

【請求項2】 エポキシ樹脂(B)100重量部に対する反応生成物(A)の配合割合が5~200重量部であり、シアン酸エステル及び/又はそのプレポリマー

(D)の配合割合が5~125重量部であることを特徴とする請求項1記載のダイアタッチペースト。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は低応力性、接着性、 低吸水性に優れておりかつワイヤーボンディング性の良 好なダイアタッチペーストに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年半導体チップの大型化、パッケージの薄型化に伴い周辺材料である樹脂材料に対する信頼性の要求は年々厳しいものとなってきている。その中でリードフレームに半導体チップを接着するダイボンディング材の特性がパッケージの信頼性を高める要因として事視されている。パッケージの信頼性で特に重要なものとして、実装時の熱ストレスに対する耐半田クラック性がある。この特性を向上させるためには半導体封止材料と同様にダイボンディング材にも低応力性、低吸水性、高接着性が要求される。しかしながら、これまでこれらの特性を全て満足する材料は知られていなかった。例えば、ダイボンディング材としてはポリアミド樹脂に無機フィラーを分散させたものがあり、接着性、低応力性に関しては優れているが、低吸水性の点で劣り、又溶剤を

用いるため硬化物中にボイドが残り易く、硬化に高温を必要とするといった欠点があった。一方、他の樹脂としてエポキシ樹脂に無機フィラーを分散させたものがあるが、接着性に優れているものの、低吸水性の点でやや劣り、又硬化物が硬く脆いため低応力性に劣るという問題があった。そこで、これらの問題を解決する目的で、骨格中にジシロキサンを含むジグリシジルエーテル化合物とビスフェノール化合物とを反応させて得られる化合物をエポキシ樹脂組成物に配合する方法(特開平7-118365号公報、特開平7-22441号公報)を検討した。その結果、上記問題を解決することができたものの、一方でワイヤーボンディング性が低下する不具合が発生した。

(C) 硬化剤、(D)式(2)で示されるシアン酸エステル及び/またはそのプレポリマー、及び(E)無機フ

ィラーを必須成分とするダイアタッチペースト。

#### [0003]

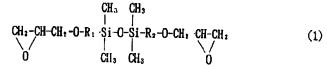
【発明が解決しようとする課題】本発明はこれらの問題 を解決するため鋭意検討した結果、低応力性、接着性、 低吸水性及びワイヤーボンディング性の良好なダイアタ ッチペーストを提供するものである。

## [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)式(1)で示されるエポキシ樹脂(a)と分子中に2個のフェノール性水酸基を有するビスフェノール類(b)とを当量比〔使用するビスフェノール類(b)の水酸基の数/使用する式(1)で示されるエポキシ樹脂(a)のエポキシ基の数〕で0.2~0.5の範囲で反応させてなる反応生成物、(B)エポキシ樹脂、(C)硬化剤、(D)式(2)で示されるシアン酸エステル及び/またはそのプレポリマー、及び(E)無機フィラーを必須成分とするダイアタッチペーストである。

[0005]

【化1】



(式中 $R_1$  ,  $R_2$  は炭素数 $1\sim$ 5の2価の脂肪族基、又は炭素6以上の芳香族環を含む有機基を示し、互いに同じであっても異なっていてもよい)

[0006]

【化2】

 $NCO-R_1-OCN$  (2)

(式中R<sub>3</sub> は芳香族環を含む2価の有機基である) 【0007】

【発明の実施の形態】本発明に用いる式(1)のエポキ シ樹脂は低弾性率、低吸水率の特徴を有するものの単独 では硬化剤との反応が遅く沸点が比較的低いので200 ℃程度の硬化温度では揮発してしまう欠点を有してい る。この揮発成分が半導体チップの表面に再付着して後 工程のワイヤーボンディングプロセスにおいて接着不良 の原因となる。そこで予めビスフェノール化合物と反応 させ、高分子量化しておくと揮発分を数%以下にまで押 えることが可能となる。特に昨今の半導体業界では歩留 り向上のためにppmオーダーのワイヤーボンディング 不良が問題となるが、数%以下の式(1)の化合物はシ アン酸エステル及び/又はそのプレポリマーとの反応性 が高いので硬化中に全て反応し揮発分をゼロにしワイヤ ーボンディング不良率をppm以下にすることができる ものである。式(1)のエポキシ樹脂(a)とビスフェ ノール類(b)の反応例としては式(1)のエポキシ樹 脂(a)とビスフェノール類とを当量比〔使用するビス フェノール類(b)の水酸基の数/使用する式(1)で 示されるエポキシ樹脂 (a) のエポキシ基の数〕で O. 2~5.0の範囲で混合し、必要により溶媒を加え10 0℃以上の条件で反応させる。当量比としては0.2~ 5. 0が好ましい。0. 2未満や5. 0を越えると一方 の原料が未反応で残ってしまい、硬化中にアウトガスと なって揮散するので望ましくない。エポキシ樹脂(a) とビスフェノール類(b)との反応を促進するために、 必要により触媒を添加してもよい。触媒の例としてはト リフェニルフォスフイン、トリブチルフォスフィン等の 有機フォスフィン類、これらの有機ボレート塩、1,8 ジアザビシクロウンデセン等のジアザ化合物等が挙げ られる。本発明に用いるビスフェノール類としては、ハ イドロキノン、レゾルシノール、ビスフェノールA、ビ スフェノールF、ビスフェノールS、テトラメチルビス フェノールA、テトラメチルビスフェノールF、テトラ メチルビスフェノールS、ジヒドロキシジフェニルエー テル、ジヒドロキシベンゾフェノン、o-ヒドロキシフ ェノール、mーヒドロキシフェノール、pーヒドロキシ フェノール、ビフェノール、テトラメチルビフェノー ル、エチリデンビスフェノール、メチルエチリデンビス (メチルフェノール)、α-メチルベンジリデンビスフ ェノール、シクロヘキシリデンビスフェノール等が挙げ られ、これらは単独でも混合して用いてもよい。本発明 で用いるエポキシ樹脂の例としては、特に限定されない が、例えばビスフェノールA、ビスフェノールF、フェ ノールノボラックとエピクロルヒドリンとの反応で得ら れるジグリシジルエーテルで常温で液状のもの、ビニル シクロヘキセンジオキシド、ジシクロペンタジエンオキ シド、アリサイクリックジエポキシドーアジペイトのよ うな脂環式エポキシ等が挙げられる。本発明の硬化剤と してはダイボンディング材のシエルフライフを損なわな いものであれば、特に限定はされない。例えば、ヘキサ

ヒドロフタール酸無水物、メチルヒドロフタール酸無水 物、ナジック酸無水物等の酸無水物、ノボラック型フェ ノール樹脂等のポリフェノール類、及びイミダゾール、 ジシアンジアミド等のアミン系化合物が挙げられる。本 発明に用いられるシアン酸エステル及び/又はそのプレ ポリマーは特に限定されるものではないが芳香族環を骨 格に含むことが耐熱性の点から好ましい。その例を挙げ ると3,3',5,5'ーテトラメチルー4,4'ージ シアナートジフェニルメタン、2,2-ビス(4-シア ナートフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-シアナ ートフェニル) エタン等の化合物とこれらを適当な金属 触媒の存在下で加熱し、シアン酸エステルを3量化して トリアジン環を一部形成したプレポリマー等がある。本 発明の式(2)で示されるシアン酸エステル及び/又は そのプレポリマーは式(1)のエポキシ樹脂との反応性 に富み本ペースト組成物中に配合することにより(A) の反応生成物中に残存する、未反応物と容易に反応し後 工程のワイヤーボンディング性を向上させる効果を有す る。本発明においてはエポキシ樹脂(B)100重量部 に対して反応生成物 (A) の配合割合が5~200重量 部であり、シアン酸エステル及び/又はそのプレポリマ ー(D)の配合割合が5~125重量部であることが好 ましい。反応生成物 (A) の割合が5重量部未満では低 応力性、低吸水性が発現しないので望ましくなく、20 ①重量部を越えるとガラス転移温度が極端に低下し、耐 熱性の点で好ましくない。シアン酸エステル及び/又は そのプレポリマーの配合割合が5重量部未満では硬化中 の揮発成分低減効果が充分に得られずワイヤーボンディ ング性が向上しないので好ましくなく、125重量部を 越えると、硬化物が固くなり低応力性が失なわれるので 好ましくない。本発明で用いる無機フィラーとしては、 炭酸カルシウム、シリカ、アルミナ等の絶縁フィラー、 銀粉、金粉、ニッケル粉、銅粉等の導電性フィラーが挙 げられ、用途によりこれらを複数混合してもよい。更 に、ニードル詰りを防止するため、これらの粒径は50 μm以下のものが好ましい。本発明によると式(1)で 示されるジシロキサン骨格を有するエポキシ樹脂をビス フェノール類と予め反応させることにより、ダイアタッ チペーストとして適度な粘度の樹脂が得られ、硬化時に 樹脂成分のブリード、アウトガスによるチップやその周 囲の汚染も極めて少なくすることができる。単に式 (1)のエポキシ樹脂を単独、又は式(1)のエポキシ 樹脂と他のエポキシ樹脂を混合したダイアタッチペース トでは硬化時にアウトガスやブリードが発生して半導体 周辺を汚染してしまうという欠点がある。本発明の樹脂 組成物は、反応生成物、エポキシ樹脂、硬化剤、シアン 酸エステル樹脂及び無機フィラー、必要に応じて硬化促 進剤、顔料、汚染、消泡剤、シランカップリング剤、チ タネートカップリング剤、溶剤等の添加剤を予備混合 し、三本ロールを用いて混練し、ペーストを得て真空脱

泡することにより製造することができる。

## 【0008】反応生成物の製造例1

ビスフェノールF(水酸基当量100)120g、式(3)のエポキシ樹脂(エポキシ当量181)90gに 触媒としてトリフェニルホスフィン0.5gを低下し1 80℃で2hr反応させた。この生成物を反応生成物 (I)とする。

## 反応生成物の製造例2

製造例1において式(3)のエポキシ樹脂を270gに 変更した以外は全く同様にして反応生物物(II)を得 た。

#### 反応生成物の製造例3

ビスフェノールF (水酸基当量100)100g、式

以下本発明を実施例で具体的に説明する。

【0010】[実施例1]エポキシ樹脂としてビスフェ ノールFエポキシ樹脂(エポキシ当量170)(以下B PFEという) 70g、希釈剤としてt-ブチルフェニ ルグリシジルエーテル(以下TGAという)30g、硬 化剤としてジシアンジアミド(以下DDAという)3 g、2-フェニル-4-メチルイミダゾール(以下2P 4MZという) 2g、反応生成物(I) 150g、旭チ バ(株)製シアン酸エステル樹脂L-10[2,2-ビ ス (4-シアナートフェニル) エタンのシアナート基を 10%反応させプレポリマー化したもの〕50g、平均 粒径3μmのフレーク状銀粉850gを配合し三本ロー ルで混練してダイアタッチペーストを調整した。このダ イアタッチペーストを用いて銀メッキ付銅フレームに2 ×2mm角のシリコンチップを200℃、60分間で硬 化接着させ、300℃における熱時接着力をプッシュプ ルゲージで測定した。同様に15×6×0.3mm(厚 さ)のシリコンチップを厚さ50µmの銀メッキ付銅フ

(3)のエポキシ樹脂(エポキシ当量181)30gに 触媒としてトリフェニルホスフィン0.4gを添加し1 80℃で2hr反応させた。この生成物を反応誠意瀬物 (III)とする。

#### 反応生成物の製造例4

ビスフェノールF(水酸基当量100)15g、式(3)のエポキシ樹脂(エポキシ当量181)180gに触媒としてトリフェニルホスフィン0.5gを添加して180℃で2hr反応させた。この生成物を反応生成物(IV)とする。

【0009】 【化3】

レームに200℃、60分間で硬化接着させ、低応力性 の尺度としてチップの長手方向を表面粗さ計を用いて上 下方向の変位の最大値を求めた。又ダイアタッチペース ト硬化物 (200℃、60分で硬化) の弾性率及び85 ℃、85%RH下での飽和吸水率を測定した。更にブリ ード性を調べた。ワイヤーボンディング性を調べるため に表面にA1蒸着したシリコンウェハーから8×8mm のダミーチップをダイシングし銀メッキ付銅フレームに このペーストを用いて200℃、60分間で硬化接着 し、25μmのAuワイヤーで250℃、2.5mse c、荷重60g、超音波パワー0.75Wの条件で1チ ップあたり100回のワイヤーボンディングを実施し た。チップ数n=10とし合計1000個のAuワイヤ ーをプッシュプルゲージを用いて剥離荷重を測定して1 g以下を不良と判断した。上記の結果を表1に示す。 [0011]

【表1】

		組成中の数字は遺量等を示す 実 施 例							
_		1	2	3	4	5	6		
	反応生成物(I)	150	30	150	150	150	1		
	反応生成物(II)		·	1		†	150		
轞	反応生成物(111)	]	1	<b>†</b>	1	·	ļ <del></del> -		
	反応生成物(IV)	1	1	1	·	† <b></b>	†		
戌	BPFE	70	70	70	70	70	70		
	TGA	30	30	30	30	30	30		
	DDA	3	9	3	3	3	3		
	2P4MZ	2	2	2	2	2	2		
	L-10	50	50	30	100	<b></b>	50		
	M-10 (*1)	1		† <del></del>	<del></del>	50			
	銀粉	850	540	840	1060	850	850		
	熱時接着力(gf/チップ)	1200	1250	1100	1500	1200	1040		
₩.	反り(μm)	20	40	18	24	23	17		
	李性字(kgf/m²)	150	300	120	220	160	105		
性	吸水率 (%)	0.10	0.24	0.12	0.15	0.11	0.08		
	ブリード性	無	無	*	無	*	海		
	ワイヤーボンディング	0	0	Ö	0	0			
	不良豪 : 旭チパ (株) 製 3,3'	1000	1000	1000	1000	1000	1000		

[実施例2~8及び比較例1~4]表1に示した配合例 に従ってペーストを調整した以外は全て実施例1と同様 に行ない、各種特性を測定して結果を表1及び表2に示

した。 【表2】

	<b>#</b> 2	_		組	戌中の数	字は重量	事を示す		
		夹	施 例	比較例					
		7	8	1	2	3	4		
	反応生成物(Ⅰ)	250	150	150			1		
	反応生成物(II)		7	1	1	·	<b>†</b>		
机	反応生成物 (III)	· [	†	1		150	†		
	汉応生成物 (IV)	1	†	†	† <b></b>	+··· <del>·</del>	150		
武	BPFE	70	70	70	70	70	70		
	TGA	30	30	30	30	30	30		
	DDA	3	3	3	2	3	3		
	2P4MZ	2	2	2	2	<u>.</u>	2		
	<b>ルー10</b>	50	150	<del> </del>	50	50	50		
i	M-10			†					
	但粉	1200	1200	750	460	850	850		
	熱時接着力(gf/fッパ)	730	1100	1150	1600	1300	870		
٠	反り(μπ)	15	50	18	78	67	30		
1	弹性率(kg!/m²)	80	420	135	560	450	130		
£	数水率(%)	0.08	0.23	0.12	0.42	0.36	0.09		
	プリード性	<b>*</b>	無	無	無	#	*		
	ワイヤーポンディング	1	0	13	0	0	10		
	不良数	1000	1000	1000	1000	1000	1000		

【発明の効果】表1及び表2に示したように実施例では つワイヤーボンディング性に優れ、しかも硬化時にブリいずれも低応力性、接着性、低吸水性に優れており、か ードがないことが判る。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

COSL 75/04

CO8L 75/04

(72)発明者 大久保 光

東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友 ベークライト株式会社内